
	<p>SI5905BDC-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5905BDC-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5905BDC-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	SI5905BDC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 3.3A, 4.5V
Leistung - max	3.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 8V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 8V 4A 3.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A
Basisteilenummer	SI5905

SI5905BDC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5905BDC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5905BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5905BDC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5905DC-T1 VISHAY SI5905DC-T1 VISHAY</p>	 <p>SI5904DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 3.1A 1206-8</p>	 <p>SI5904DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 3.1A 1206-8</p>	 <p>SI5905BDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p>
 <p>SI5904DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 3.1A 1206-8</p>	 <p>SI5905BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p>SI5904DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 3.1A 1206-8</p>	 <p>SI5905BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 4A 1206-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5905BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5905BDC-T1-E3-Datenblätter	SI5905BDC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI5905BDC-T1-E3 Electronic	SI5905BDC-T1-E3-Komponenten	SI5905BDC-T1-E3-Bild	SI5905BDC-T1-E3
SI5905BDC-T1-E3 Preis	SI5905BDC-T1-E3 Hersteller	SI5905BDC-T1-E3-Aktie	SI5905BDC-T1-E3-Teil
SI5905BDC-T1-E3 Neu	SI5905BDC-T1-E3 Original	SI5905BDC-T1-E3-RFQ	SI5905BDC-T1-E3-Inventar
	SI5905BDC-T1-E3-garantiert		SI5905BDC-T1-E3-Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited